

ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ СЛОЕВ С ICP ИСТОЧНИКОМ

ПЛАЗМА ТМ 09

Назначение: Плазмохимическое селективное (реактивно-ионное, анизотропное) травление кварца, пирекса, алмазных плёнок, карбида кремния и других труднотравимых диэлектрических и полупроводниковых слоёв.



Особенности:

- Групповая или индивидуальная обработка подложек в одном технологическом цикле: 60x48 мм – 3 шт.; Ø 76, 100, 150 – 1 шт.;
- ВЧ электрод с охлаждением подложек;
- Скорости травления 0,5 - 1,5 мкм/мин;
- Измерение ВЧ смещения на ВЧ электроде-подложкодержателе от 0 до 1000В;
- Регулирование и автоматическое поддержание уровня мощности ВЧ ICP источника плазмы в диапазоне 400-600 Вт;
- Мощность потребления не более 7 кВт;
- Рабочие газы: O₂, SF₆, C₄F₈, CHF₃ и др.;
- Безмасляная система откачки;
- Возможность встраивания в чистую комнату.

